









	<h2 style="color: red;">IPD082N10N3GBTMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IPD082N10N3GBTMA1
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 80A TO252-3
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPD082N10N3GBTMA1.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD082N10N3GBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 80A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 75µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.2 mOhm @ 73A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3980pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPD082N10N3GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD082N10N3GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD082N10N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD082N10N3GBTMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>IPD082N10N3G</b> infineon IPD082N10N3G infineon	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>IPD07N50C3</b> Original TO-251	 <b>IPD088N04LGBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3	 <b>IPD082N10N3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 80A TO252-3
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>IPD088N04LG</b> Infineon IPD088N04LG Infineon	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>IPD088N06N</b> INFINEON IPD088N06N INFINEON	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>IPD088N04L G</b> INFINEON IPD088N04L G INFINEON	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. <b>IPD082N10N3 G</b> INFINEON IPD082N10N3 G INFINEON

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD082N10N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD082N10N3GBTMA1 Datenblatt	IPD082N10N3GBTMA1-Datenblätter	IPD082N10N3GBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD082N10N3GBTMA1
IPD082N10N3GBTMA1 Electronic	IPD082N10N3GBTMA1-Komponenten	IPD082N10N3GBTMA1-Verteiler	IPD082N10N3GBTMA1-Bild	IPD082N10N3GBTMA1-Teil
IPD082N10N3GBTMA1 Preis	IPD082N10N3GBTMA1 Hersteller	IPD082N10N3GBTMA1 Bild	IPD082N10N3GBTMA1 Aktie	IPD082N10N3GBTMA1 Inventar
IPD082N10N3GBTMA1 Neu	IPD082N10N3GBTMA1 Original	IPD082N10N3GBTMA1 garantiert	IPD082N10N3GBTMA1 RFQ	IPD082N10N3GBTMA1 Online bestellen